

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им.

А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

научного сотрудника

в лаборатории физики полупроводниковых гетероструктур

Вакансия VAC 118249

Тематика исследований

Фундаментальные и прикладные исследования свойств полупроводниковых гетероструктур на основе соединений АЗВ5 и оптоэлектронных приборов на их основе.

Трудовая деятельность

- Организация и проведение научных исследований оптических и электрических свойств полупроводниковых гетероструктур на основе соединений А³В⁵, в том числе гетероструктур с пониженной и переходной размерностью (квантовые ямы, квантовые точки, квантовые яма-точки).
- Исследование свойств торцевых лазеров, суперлюминесцентных лазерных диодов, кольцевых, микродисковых лазеров и других полупроводниковых приборов с различными типами активной области в составе коллектива лаборатории физики полупроводниковых гетероструктур.
- Работа на экспериментальных установках по исследованию оптических и электрических свойств полупроводниковых приборов.
- Подготовка научных публикаций в рецензируемые журналы, индексируемые в системах Web of Science и/или Scopus.
- Подготовка и представление результатов исследований на конференциях и семинарах;
- Подготовка заявок на участие в конкурсах научно-исследовательских проектов, участие в работах по выполнению научно-исследовательских проектов.

Требование к претенденту

- Степень магистра по направлению подготовки электроника и наноэлектроника;
- Диплом об окончании аспирантуры с квалификацией “Исследователь. Преподаватель-исследователь” по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия по профилю физика полупроводников;
- Опыт работы не менее 4 лет в области физики и технологии полупроводниковых гетероструктур АЗВ5 и полупроводниковых приборов на их основе;
- Опыт работы на экспериментальных установках для исследования фото- и электролюминесценции, оптической мощности в непрерывном и импульсном режимах, распределения интенсивности в ближнем и дальнем поле, концентрации и подвижности носителей заряда в полупроводниках, тока прозрачности. Опыт автоматизации проведения экспериментов на перечисленных установках;
- Наличие не менее 20 публикаций в рецензируемых научных изданиях (в т.ч. не менее 1-го – в изданиях первого квартиля WoS/Scopus) за последние 5 лет, выступление с устными и стендовыми докладами на 5 и более российских и международных конференциях;
- Успешный опыт выполнения проектов для получения субсидий для молодых ученых, молодых кандидатов наук вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, проводимых комитетом по науке и высшей школе;
- Выполнение проектов российских научных фондов (РНФ, РФФИ, не менее 5-и за последние 5 лет);

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 27 228 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000

Срок трудового договора – 5 лет.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.